

(様式1)

委員会委員公募案内

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】		化合物半導体を用いた次世代高機能デバイス技術とアプリケーション(第二期)調査専門委員会 (C 部門)【電子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)
設置期間		2025 年 12 月～2027 年 11 月 (令和 7 年 12 月～令和 9 年 11 月)	本委員会では、種々の化合物半導体を用いた次世代高機能デバイス技術と、それに最適な将来システム/アプリケーションに関する調査を行います。材料・プロセスからシステムまで同技術の適用性に関する知見を得ることを活動の目的としています。
委員長名 (所属)		南條 拓真 (名古屋工業大学)	
委員会開催頻度		5 回/年	
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)	星 拓也 (NTT 株式会社)	
	E-mail アドレス	takuya.hoshi@ntt.com	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など		半導体、電気、電子、光学、化学、物理学、デバイス、プロセス、回路、実装、結晶に関する研究、開発に従事または興味を持っている方。電気学会会員あるいは入会していただける方が望ましい。	
応募締切		随時応募	
協同研究委員会の場合の委員の負担			0 円/年